

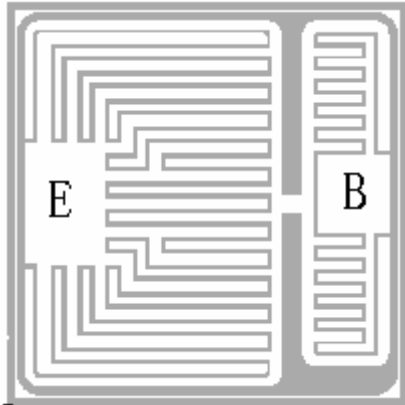
ND2.5

硅 NPN 外延平面达林顿晶体管芯片

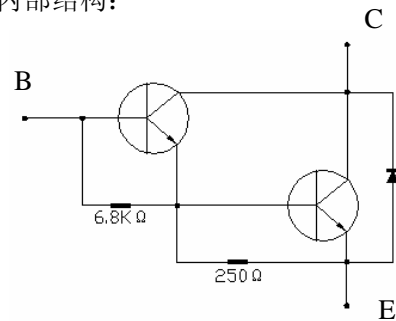
■ 用途:

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■ 芯片示意图:



■ 内部结构:



■ 几何结构:

芯片尺寸	2500 μ m×2500 μ m
压焊区尺寸	基 极 440 μ m×490 μ m 发射极 500 μ m×750 μ m
锯片槽宽度	90 μ m
芯片厚度	270±10 μ m
金属层	正面 Al 3.4±0.4 μ m 背面 Ag 1.4±0.2 μ m

■ 电特性 (T_a=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极-基极击穿电压	BV _{CBO}	I _C = 0.1 mA, I _E = 0	290	150		V
集电极-发射极击穿电压	BV _{CEO}	I _C = 10 mA, I _B = 0	150	100		V
集电极--发射极维持电压	V _{CEO (sus)} *	I _C =30mA, I _B =0		100		V
发射极--基极击穿电压	BV _{EBO}	I _B =1mA, I _C =0		6		V
集电极-基极截止电流	I _{CBO}	V _{CB} = 100V, I _E = 0			1	μ A
集电极-发射极截止电流	I _{CEO}	V _{CE} = 100V, I _B = 0			2	μ A
发射极-基极截止电流	I _{EBO}	V _{EB} = 15V, I _C = 0	2.2		3.0	mA
直流电流增益	h _{FE}	V _{CE} = 5V, I _C = 2A	4000	2000	15000	
集电极-发射极饱和电压	V _{CES}	I _C =4A, I _B = 16mA	1.4		2	V

* V_{CEO (sus)}: 脉宽≤300 μ s, 占空比≤2% (TO—220)